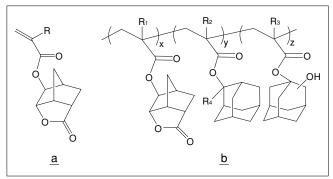
開発秘話:ArFレジスト材料 一成長と創出ー

元日本電気株式会社 中央研究所(現高分子学会フェロー) 長谷川 悦雄

■ はじめに

日本電気株式会社(以下NECと略)のわれわれの研究グループが開発した材料[脂環ラクトン(通称:NECラクトン)モノマー]を図1aに示す。この材料と他材料との共重合体[コポリマー(図1b)]が、ArFドライ露光用レジストとして2003年ごろから半導体の90nm微細加工にデファクト材料として使われ始め、最近では22nmのArFウエット露光にも使用されている。



図I ArFリソグラフィー用レジスト材料 (NECラクトン) (R, RI~R3:水素、メチル基; R4:アルキル基; a:モノマー; b:コポリマー)

私が所属した「有機機能材料研究部」は、「21世紀には有機材料が重要な技術になる」との中央研究所トップによる先進的判断から、1989年夏に設置された。大半の研究者が新卒者(修士)であった。新鮮な研究員を育てながら研究を進める思想ではあるが、事業部門との委託研究関係により、具体的な事業貢献が求められた。私は1991年に入部し、10名ほどの若い研究員とともに3テーマ(フォトレジスト、液晶、導電性高分子デバイス)を推進した。開発した導電性高分子コンデンサが「NEOキャパシター」として1993年に量産され、また高分子分散液晶型のa-Si TFT駆動プロジェクションディスプレイを開発し、1995年の国際情報ディスプレイ学会(SID)コンファレンスで受賞した。しかし、いずれも知的財産に関わる課題の重要性が身に染みた。

■ 開発の決断

16

1990年前後には、KrFエキシマレーザ(波長:248nm)リソグラフィー以降の先端半導体回路製造用の露光技術(露光光源、露光装置、レジストなど)について、世界中の半導体メーカーが心配し始めていた。KrFリソグラフィーによる実際の半導体量産は1995年ごろからであったので、KrF以降のリソグラフィーが量産適用になるのは2000年代の初期以降になることになる。1990年ごろには、NECの事業部門と中央研究所との間に「次世代リソグラフィー技術に関するプロジェクト」が設置され、定期

的な情報交換を始めていた。当時は、KrFに次ぐ次世代露光光として多くの選択肢があり、NEC内では、等倍X線、電子線、エキシマレーザーに関する研究・開発が行われていた。事業部門としては、水銀灯g線、i線、KrFエキシマレーザーと続く「通常の光」が、製造プロセスの継続性から望まれていた(と思う)。しかし、より短波長のArFエキシマレーザー(波長:193nm)「光源そのもの」についても全く見通しがついていない状況の中、「新研究部にふさわしい未来テーマを行うべき」との新研究部の意気込みから、「次世代露光光はArFエキシマレーザー」であると判断し、そのフォトレジストの研究に1991年ごろから本格的に着手した。

■ 研究·開発方針

以上述べてきたように、当研究部でのArFエキシマレーザー レジスト材料の開発は、ある意味で「無謀な挑戦 |とも言える。 「10年後に使われるかどうかも分からない(ArFリソグラフィ ー用)材料研究テーマを新人グループで開始」と不安を感じる のが、担当する研究員の率直な思いであった(だろう)。研究員 のモチベーションの確保と維持が極めて重要であった。私はと 言えば、興味に溢れ、研究・開発に大きな期待を持った日々で あった。一方では、10年という長期が初めから決まっている からこそ、ゆっくりではあるが着実な研究開発を進める余裕が あると考え、10年計画で焦らず臨んだ。結果は10年後にしか出 ない。その時、研究員にとっての成果は知的財産権の形でしか 残らないと考え、本研究テーマでは知的財産権の確立に特に注力 した。研究開始の数年間は若手の教育期間、その後に材料のオ リジナルな設計手法を確立し、その後はその手法に基づき材料 を発展展開していくことを想定した。結果として、1995年ごろに 材料設計指針「機能統合型構造設計法 |を確立、1998年には その手法に基づき「NECラクトン」の創出に成功した。

企業での研究(および開発)のポイントは新技術の開発にあるものの、私が若い研究員に折に触れて話したことは、(1)創造性(creativity)の発揮、(2)知的財産権の確保、(3)健康の維持、この3点である。フォトレジスト開発テーマでは、1990年から毎年、新卒の化学系修士計3名を研究員として採用した。私はそれをマネジメントする立場として1991年春に配属され、フォトレジスト開発では主に4名のグループで10年間実施した。入社前にフォトレジストの研究を経験した者はいない。すべての新卒採用者は、事業部門の開発研究所微細加工技術開発部に1年~2年間派遣され、当時の最先端露光(KrF)プロセスに携わり、最先端リソグラフィープロセスを習得し、事業部門の状況を学んだ。この間に指導していただいた世界トップレベルの事業部門開発部

SEMI News • 2013, No.2

の方々との人的交流が、その後のフォトレジスト開発推進に極めて有効に働いた。また1990年代のNECは、世界トップ (第2位~3位)の半導体メーカーであった。高い技術力を持ち、研究所として学ぶべき多くの「もの」を有していた。国内の半導体装置メーカーや半導体材料メーカーとの連携が強く、当時の最先端の装置・材料の入手が極めて容易であった。フォトレジスト開発初期に最先端のArFレンズツール (ニコン製1/20縮小露光、NA0.55)を用いた材料の評価が可能であった点は、有機機能材料研究部の研究の優位性確保に重要であった。

■ 学会動向

研究初期からフォトレジストの学会(フォトポリマーコンフ ァレンス、応用物理学会など)に参加するようになり、各社の学 会動向から「われわれのグループでも十分にやっていける」と いう確信を私は得た。ArFレジストに関する研究・開発は、世界 中の半導体メーカー(IBM、AT&T、東芝、日立、富士通、松下)が 実施しているが、狭い世界であること、さらには化学メーカーが ほとんど参入していないという幸運があった(当時の化学メー カーは、KrF対応の量産用フォトレジストの開発に注力してい た)。化学メーカーは、学会発表で材料の化学構造を明かさない のが常である。これでは科学的議論ができない。一方、先端半導 体メーカーは、ISSCC(International Solid-State Circuits Conference)で見られるように、自社技術優位性を市場に一刻も早く開 示するため学会発表を積極的に行う。同様にArFレジスト研究 の学会発表も盛んに行われ、併せて材料の化学構造の開示が行 われた。結果的に、「化学構造と特性の関連付け」が第三者に相 当程度明確であった。構造-活性相関による材料設計は、私が 20年近く行ってきた深い経験が生かされる領域であった。この 自信を「研究員の自信」にすることが、私のひとつの重要な役割 であった。研究員には国内・国際学会での発表を積極的にや らせた(図2)。学会での若手講演賞を全員が受賞した。国内を 含む世界の先端研究者との頻繁な議論や接触は、研究員のモ チベーションアップを可能とした。

■ 知的財産権確保と化学メーカーへの展開

研究員に成果の学会発表を推奨し、研究モチベーションを高めるとともに、知的財産権の確保を積極的に行った(図2)。特許出願に関わる独自のシステムを研究部内に構築し、出願の促進と記載内容の向上を図った。すべての特許出願提案書、明細書案について目を通し、出願後のフォローを徹底的に行い、権利の確保を支援した。これにより研究員の特許意識が高まり、皆が優れた特許明細書を書ける技術を得た。この結果、「NECラクトン」に関する特許出願は、特許庁からの異議なしで出願の1年半後に成立した。

絞り込んだフォトレジスト材料の化学メーカーへの展開を、 1990年代後半に積極的に行った。研究としてのオリジナル性が 極めて高く且つ解像特性が高い「カルボキシ脂環骨格」材料の

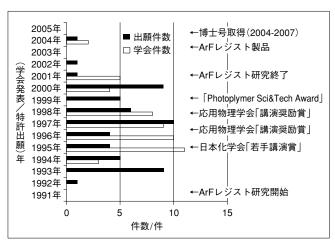


図2 ArFフォトレジスト関係の学会発表/特許出願件数

展開を図ったが、結局は原材料の量産コストが高く、採用されなかった。それ以後に絞り込んだ「脂環ラクトン」材料は、解像における優れた特性と原材料製造の低コスト特性を併せ持ち、量産用フォトレジスト材料として化学メーカーに採用された。

■ おわりに

NECでのArFレジスト材料開発は2000年ごろに終了した。 開発の結果として「NECラクトン」成果は、各種の表彰(日本 化学会技術賞、全国発明表彰経団連会長賞など)を受けた。併せ て、携わった3名の「若手」研究員は、その間に研究者として大 きく成長し、プロジェクト終了後に全員が博士号を取得した(図 2)。事業成果だけでなく個人成果を併せて得ることができた。 真摯な個人の努力が報われ幸いであった。

ArF光源に続く次世代光源であったF2光源(波長157nm)露光は、有名な2003年の「インテルショック」により中断され、各社が開発に注ぎ込んだ労苦は吹き飛んだ。20年前にArF光源に絞って始めた我々の開発が、このようなショックなしで終われたことは幸いであった。ArF光源の次世代光源として「EUV(波長13.6nm)」技術が広く検討されているが、技術的に困難な問題がまだ残っている。2012年夏の報道では、IntelがASMLの量産露光機開発に資金供与を行うとのこと。他方で、ArF光源での液浸法、ダブルパターニング法の実用化を経て、マルチパターニング法などで11nmも可能との見方もある。光源・露光法での「ショック」再来はあるか。

<参考文献>

- 長谷川悦雄、前田勝美「ラクトン骨格を有するポリマーの研究開発動向」、『高分子』、57巻10月号、850-855 (2008)
- ・稗田克彦、島 基之「フォトリソグラフィー材料の最新動向」、 『高分子』、55巻2月号、74-77 (2006)
- ・長谷川悦雄、土田英俊「人工血液と人口赤血球」、『高分子』、 38巻7月号、728-731 (1989)
- 野崎耕司 「ArF液浸レジスト」、『高分子』、60巻3月号、135-136 (2011)